

インピーダンスアナライザ

ZA57630

Impedance Analyzer

基本確度 ±0.08%

測定周波数 10 $\mu Hz \sim$ 36 MHz

電子部品・半導体デバイスから、材料・素材の特性評価まで、さまざまなインピーダンス測定ニーズに対応 ———



幅広い DUTに対応

これからは、業界標準

True Value

真の特性を測る。

電子部品・半導体デバイス・材料・電池・・・ 実際の使用条件で測定する。

エヌエフのインピーダンスアナライザ ZA57630



基本確度

±0.08%

インピーダンス範囲

10 $\mu\Omega\sim 100$ G Ω (外部拡張測定モード)

DC バイアス

-5 V \sim +5 V / -40 V \sim +40 V (1 kHz以上) $-100 \text{ mA} \sim +100 \text{ mA}$

周波数範囲

10 μ Hz \sim 36 MHz

測定 AC 信号レベル

0.01 mVrms \sim 3 Vrms $0.1 \mu Arms \sim 60 mArms$

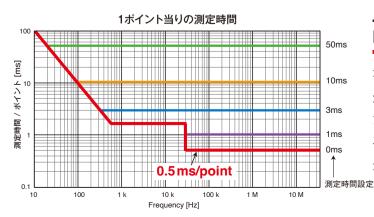
.5ms/poi

測定時間

0.5 ms/point

測定パラメタ

Z, R, X, Y, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, θz, θy, D, Dε, Dμ, Q, V, I, ES, ES', ES'', µS, µS', µS'', FREQUENCY



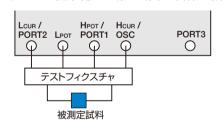
高速測定

業界最速の0.5ms/pointを実現しました。 生産ラインのタクトタイム短縮や測定作業の効率化に。 また、設定する測定時間を増やすことにより、測定結果が 平均化され、ノイズの影響が軽減されます。必要に応じて 最適な測定時間を選択いただけます。

4つの測定モード

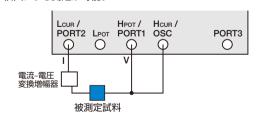
●標準測定モード(IMPD-3T)

幅広い周波数範囲で高確度な測定が可能なモード。テストリードや テストフィクスチャが使用可能で、様々な形状の試料に対応。



●外部拡張測定モード(IMPD-EXT)

外部に増幅器やシャント抵抗などを接続して測定するモード。 本器のみでは対応できない、高電圧の信号印加や微小電圧/電流の



●高周波測定モード(IMPD-2T)

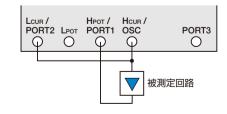
10MHz以上の高周波で安定した測定が可能なモード。N型コネクタ使用の 2端子測定で、配線が長い場合も安定した測定が可能。

DUTIE



●ゲイン・フェーズ測定モード(G-PH)

フィルタやアンプなどの伝達特性測定が可能なモード。スイープ信号を 被測定回路に与え、その周波数応答(利得、位相)を高精度に測定。



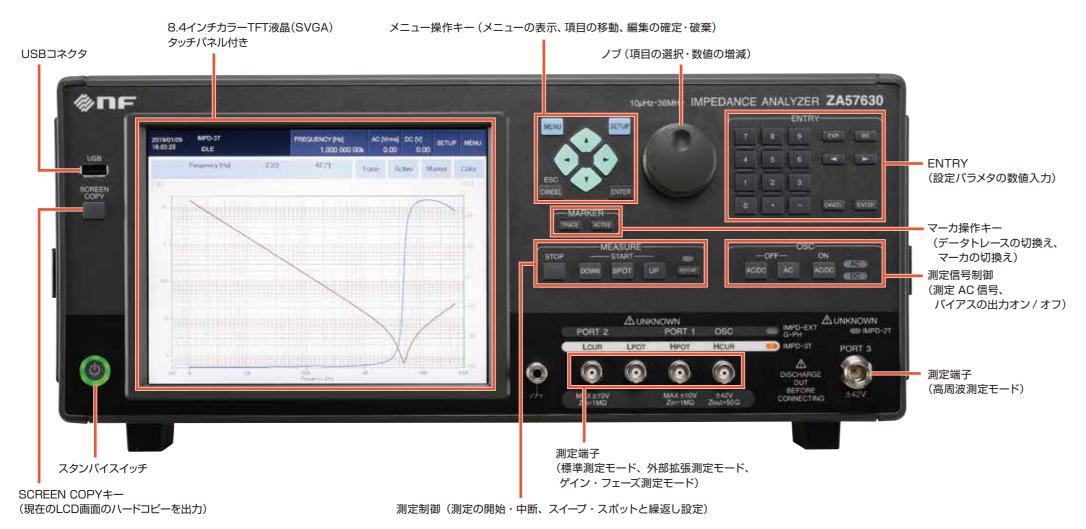
正面パネル

外部拡張測定モード ゲイン・フェーズ測定モード 標準測定モード



高周波測定モード

見やすいディスプレイとタッチパネル、多彩な機能を 直感的な操作で。



汎用的な電子部品にも、絶縁材などの電子材料にも。 4つの測定モードが測定対象の幅を広げます。

■標準測定モード (IMPD-3T)

汎用性が高く、高確度測定が可能です。

- 推奨周波数帯域: 10 μHz ~ 10MHz
- 推奨インピーダンス値: 1Ω~10MΩ
- ●各種テストリード、テストフィクスチャを接続して各種電子部品や様々な 形状の素材の測定に。
- 4 端子接続、3 端子接続が 容易に行えます。

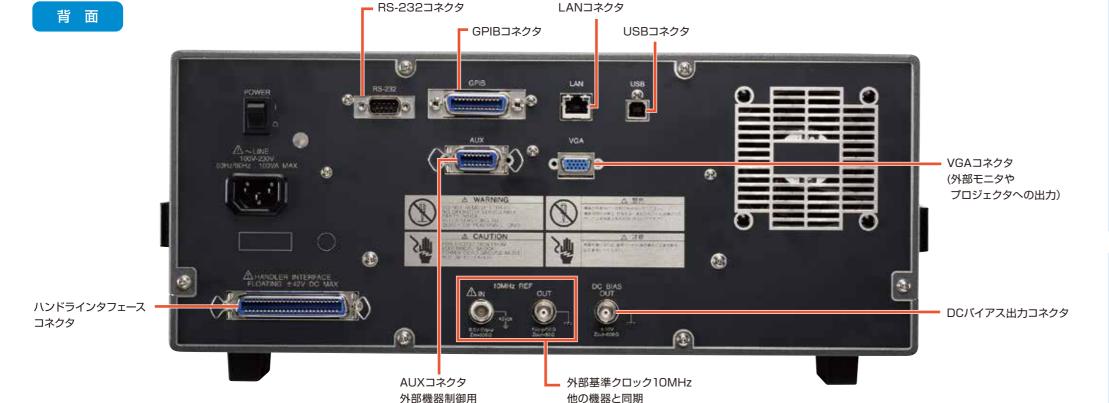


高周波帯域で安定した測定が可能です。

- ●推奨周波数帯域: 10MHz~36MHz
- ●推奨インピーダンス値:200mΩ~10kΩ
- ●N 型コネクタ使用 2 端子接続
- ■ポート延長機能により、被測定試料までの 配線が長い場合にも安定した測定が可能。 恒温槽や検査装置への組み込みに有効。







■外部拡張測定モード(IMPD-EXT)

高電圧 / 大電流信号印加用パワーアンプや、微小信号測定用 プリアンプを併用して広範囲なインピーダンス測定が可能です。

- ●測定可能インピーダンス範囲 $10\mu\Omega \sim 100G\Omega$
- ●ギガΩを超える絶縁材料やミリΩ・マイクロΩオーダの電線や銅箔など素材・材料の測定に。
- ●当社の豊富な増幅器のラインナップから、 測定試料にあった組み合わせを提案可能です。
- 注:増幅器など外部に接続する機器の 仕様によって測定可能な範囲は 制限されます。





■ゲイン・フェーズ測定モード(G-PH)

フィルタ回路の入出力特性、サーボ機構の特性測定などの伝達特性測定に。

- ●周波数帯域: 10 µHz~36MHz
- ●測定確度 ゲイン 0.01dB、位相 0.06°
- ●ダイナミックレンジ 110dB typ.

用途にあわせた多彩な機能を搭載! DUTの特性に最適な

正確な評価は、実際に使われる動作条件で。

電子部品や電子材料は測定周波数や印加される信号レベルなどによって異なる特性を示すことがあります。コンデンサやインダクタは寄生成分に よる周波数依存性があり、ダイオードなどの半導体デバイスは DC バイアス重畳により特性が変化します。

真の特性を評価するには、周波数、AC 振幅、DC バイアスをスイープさせ、実際の動作条件化で測定することが重要です。

■スイープ

周波数、AC振幅、DCバイアス、ゼロスパン

●AC 振幅スイープ



■■ スポット測定にも対応 一定の周波数 /AC 振幅 /DC バイアスで測定し、測定結果

を数値表示。最大6項目を 設定可能です。 コンパレータ機能と組み合わ

せて、選別や良否判定を行う ことができます。



生産ラインにおける測定に

周波数スイープ 10,000 00 4,230 M 47,983 Trock Action C During 36.300000000000 MHz 4 F A T ● DC バイアス スイープ 18.58 V

●ゼロスパン

周波数、AC 振幅、DC バイアスのパラメタを変更せずに一定の 条件で測定し、時間による特性の変化を観察(横軸:時間)

測定条件等の設定

詳細設定は1画面で直感的に

● 設定項目 (SETTING VIEW)



設定により、再現性の高い、正確な測定をサポートします。

測定レンジ

●オートレンジ

測定結果を監視しながら、最適なレンジを自動設定して測定します。 レンジを超える外来ノイズや直流成分を検出した場合には、大き なレンジに設定し直して、再測定が行われます。測定データの変 化が大きい場合に有効です。

固定レンジ

測定レンジ固定のため、レンジ変化に伴う測定値の不連続(段差) が生じません。

スイープの進行において周波数や AC 振幅などのスイープパラメ タが変更されると、過渡応答によって測定結果に誤差が生じます。 パラメタ変更後、測定開始までの時間を遅延することができます。 測定の開始時に遅延する「測定開始遅延」とスイープ中のパラメ タ変更ごとに遅延する「測定遅延」があります。

■自動高密度スイープ

周波数スイープ測定において、測定データが急変する区間だけ、 自動的に周波数密度を上げて測定する機能です。

圧電振動子や水晶振動子等の共振特性測定において、位相が急激 に変化する共振付近の測定に有効です。

正確な評価には、測定誤差要因に応じた補正を。

■誤差補正

正確な測定をするためには、残留インピーダンスやケーブル長な どの各種測定誤差要因を適切に補正することが必要です。

●オープン補正

残留アドミタンスによる誤差を低減

●ショート補正

残留インピーダンスによる誤差を低減

ロード補正

既知の値を持つ試料を標準インピーダンスとして、真値からの ずれを補正

●ポート延長

長いケーブルを使用したときに、伝搬遅延時間で発生する位相誤 差を補正

●電位勾配除去

測定信号に含まれる電位変動波形の影響を除去。電池などの 充放電に伴う電位変化がある試料の測定に有効

●イコライズ

外部に接続したセンサやケーブルなどの測定系の周波数特性を あらかじめ測定し、測定系の誤差分を補正

入力重み付け

プローブの減衰量やプリアンプのゲインを補正

●セルフキャリブレーション

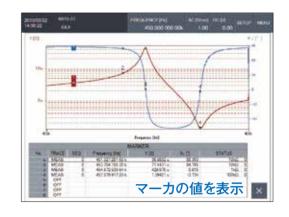
自己誤差の補正

■マーカ操作

表示されるグラフの X. Y1. Y2 の測定値を読み取る機能です。

最大8マーカを使用可能です。

- △マーカ 基準マーカ(マーカ 1)との差分を表示
- ATRKG マーカ
- Δマーカ同様に差分を表示し、マーカ 1 を移動した場合、 スイープ値の差分を一定に保ちながら移動
- ●マーカサーチ機能 設定条件に合致する点を自動的にサーチ可能



■シーケンス測定

あらかじめ必要な測定条件を複数設定しておき、その条件にて順 次測定していく機能です。スイープ範囲を最大32分割して、各 節囲で異なる測定条件で測定できます。

電圧値により特性が変化する積層セラミックコンデンサ (MLCC)、 インダクタやトランスなどを効率よく測定できます。

■グラフ表示

● SINGLE 表示 / SPLIT 表示

1 画面 1 グラフの "SINGLE" と上下にグラフを 2 つ表示する "SPLIT" を選択可能

●位相表示操作

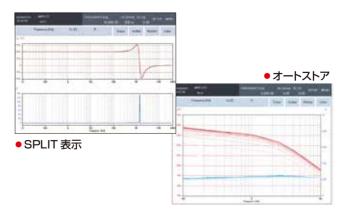
±180°、0°~+360°、-360°~0°、UNWRAP(連続表示)、 360°シフト. アパーチャ (群遅延特性)

● トレース操作

測定データトレース (MEAS) と最大8本の参照データトレース (REF) を重ね書き可能

●オートストア

スイープ測定が終了したら、MEASトレースを REFトレースに自動 でコピーする機能。時間とともに変化する特性の観測に有効です。

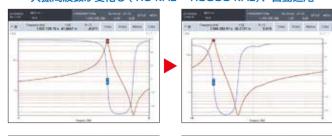


■共振点追尾測定

共振を有する試料の測定において、測定周波数を試料の共振周波 数に自動追尾する機能です。 試料に振幅依存性がある場合や時間 変化で共振周波数が変動する場合でも、常に共振周波数と一致し た測定が可能です。

圧電素子の共振点近傍での連続測定に便利な機能です。

共振周波数が変化し(1.6 kHz→1.5858 kHz)、自動追尾







■等価回路推定

周波数スイープ測定で得たインピーダンス特性を等価回路モデルに 当てはめ、LCR 素子の値(インダクタンス値、静電容量値、抵抗値) を求める機能です。以下の6種類のモデルが用意されています。 等価回路推定結果は、CSV 形式で保存できます。

●等価回路モデル

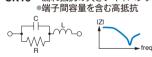
CKT1 コアロスの大きいインダクタ



CKT2 ●ESR の大きいインダクタ



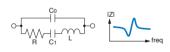
CKT3 ●漏れ抵抗の大きいキャパシタ



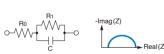
CKT4 ESR、ESL を含む一般的なキャパシタ

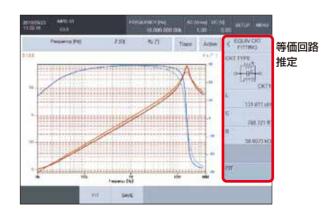


CKT5 ●水晶振動子、圧電振動子など



CKT6 ●電池など電気化学インピーダンス



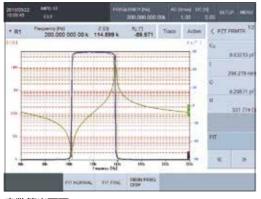


■ 圧電定数算出

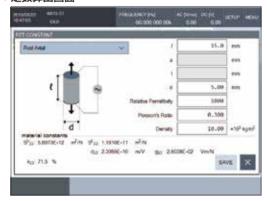
圧電セラミックスの周波数ーインピーダンス特性を測定して、電 気機械結合係数や圧電定数などを算出する機能です。

JEITA 規格『EM-4501A F電セラミック振動子の電気的試験方 法』に準じた方法で、パラメタを算出しています。

• 測定結果表示



• 定数算出画面

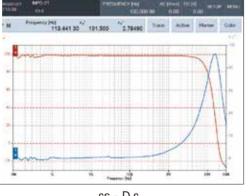


■比誘電率測定

試料の寸法などの情報をあらかじめ設定して、インピーダンス 測定結果 (Cp, Rp) を複素比誘電率に換算して表示できます。

●比誘電率 εs ●比誘電率実部 εs´●比誘電率虚部 εs´ ●損失率 Dε





εs - Dε

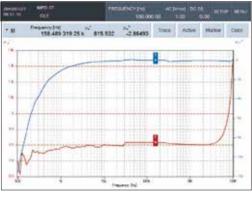


■比透磁率測定

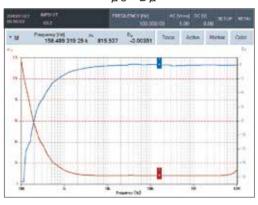
試料の寸法などの情報をあらかじめ設定して、インピーダンス 測定結果(Ls. Rs)を複素比透磁率に換算して表示できます。

●比透磁率us ●比透磁率実部 us´ ●比透磁率虚部 us´ ●損失率 Du

us' - us'



us - Du



外部基準クロック

高精度の 10MHz 基準信号を入力することにより、測定周波数の 確度や安定度を向上できます。

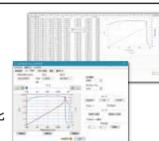
また、他の機器と共通の基準クロックを用いることで、周波数確度 を共通にすることが可能です。

メモリ操作

測定条件および測定データは、内蔵メモリまたは USB メモリに 保存・読み出しが可能です。

コントロールソフトウェア

- ●測定条件の設定
- ●測定データの表示・保存
- ●補正機能
- ●測定データを Excel ファイルへ 自動転送(ログ出力機能)、 データ加工やグラフ作成を自動化
- ●コマンド直接送信機能



生産ラインに!

*当社 Web サイトよりダウンロードしてご使用ください。

電気化学インピーダンス特性測定に

- ●超低周波10µHzから測定可能
- ●電位勾配除去機能により、充放電に伴う電位変動の測定への

測定速度 最速 0.5 ms/point でタクトタイム短縮 さらに、部品選別機能も充実!!

■コンパレータ・ハンドラインタフェース

コンパレータは、測定結果に対して判定範囲をあらかじめ設定し、 試料を選別するための分類や合否判定をする機能です。

●コンパレータ設定画面



●ハンドラインタフェース

コンパレータの判定結果を背面パネルに装備している ハンドラインタフェースコネクタに出力できます。 部品ハンドラを接続することで、部品の自動判別システム を構築できます。

判定結果 1.668 31 10 BIN ●リミット判定 0.172 811 測定結果を設定した範囲で 合否判定する機能です。 La 254.138 *** Pie 1.668 30 kg 1.667 42 kg -0.003 01 0.097 PROJENCY 3.140 271 400 00 M La 143.220 判定結果 ●ビン判定 測定結果を、最大14通りに Ple 1.667 42 № 分類する機能です。 -0.001 69 FREQUENCY 3.140 271 400 00 MHz バーグラフ -1000 000 100 116 704 25.748 have been from the (判定結果の相対位置)

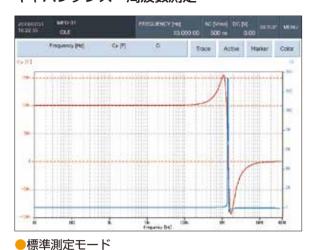
PASS

●ゾーン判定 スイープ測定結果を、X軸(スイープ パラメタ)とY1·Y2軸(測定結果)の 2次元で合否判定する機能です。

コンデンサ

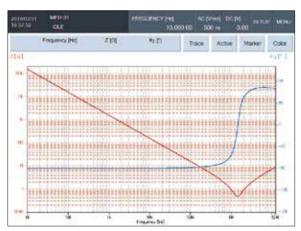
O.1 μF コンデンサ(リード部品)

キャパシタンスー周波数測定



III 0.1 μF コンデンサ(リード部品)

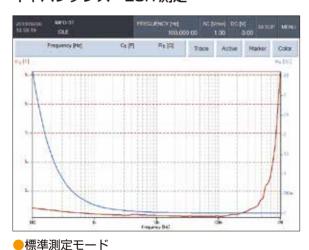
インピーダンス-周波数測定



●標準測定モード

4.7μF コンデンサ(SMD 部品)

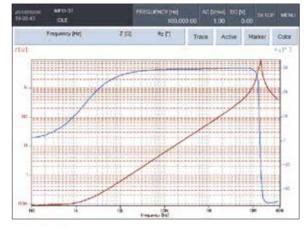
キャパシタンス-ESR 測定



インダクタ

10μH インダクタ(SMD 部品)

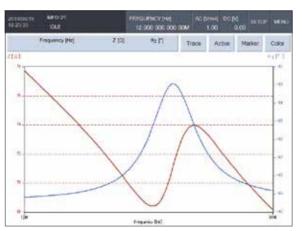
自己共振周波数測定



●標準測定モード

■ RFID用送信アンテナ インダクタ(基板実装)

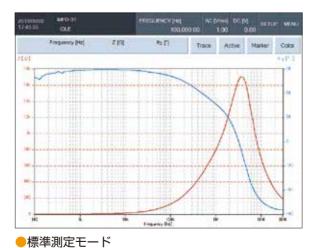
共振周波数測定



●高周波測定モード

■ 220µH 巻線インダクタ

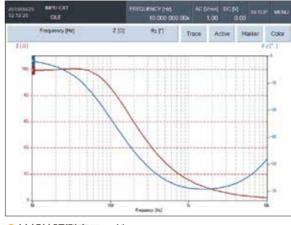
自己共振周波数測定



抵抗

10GΩ抵抗

高抵抗測定

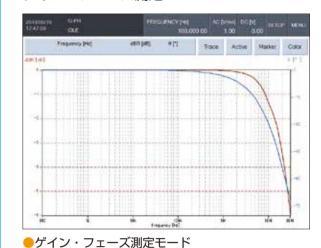


●外部拡張測定モード 広帯域電流増幅器 SA-604F2 を電流検出に使用

電子回路

CR フィルタ(fc≒10 MHz)

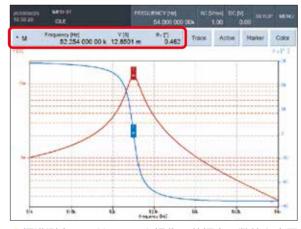
ゲイン・フェーズ測定



圧電素子

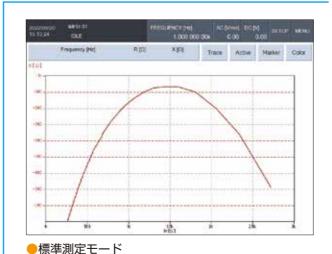
圧電セラミックス振動子

共振周波数測定



●標準測定モード、マーカ操作で共振点の数値を表示

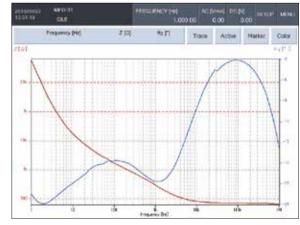
電池



液体

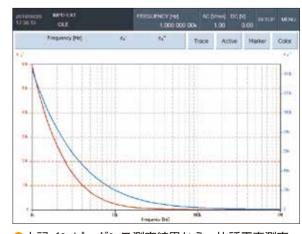
水

インピーダンス-周波数測定



●標準測定モード、液体用テストフィクスチャ使用

誘電率測定



●上記インピーダンス測定結果から、比誘電率測定 機能を用いて、誘電率を算出 (ε s´, ε s´´)

▼ 測定モード

測定モード	標準測定モード(IMPD-3T)
	高周波測定モード(IMPD-2T)
	外部拡張測定モード(IMPD-EXT)
	ゲイン・フェーズ測定モード (G-PH)

▼ 測定値表示範囲

●標準測定モード (IMPD-3T), 高周波測定モード (IMPD-2T)

-1xx1x		
Z		0 Ω ~ 999.999 GΩ
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
R, X		± (1 a ~ 999.999 G)Ω および 0 Ω
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
Υ		0 S ~ 999.999 GS
		分解能 6 桁 または 1 aS
G, B		± (1 a ~ 999.999 G) S および 0 S
		分解能 6 桁 または 1 aS
Ls, Lp		±(1 a ~ 999.999 G) H および 0 H
		分解能 6 桁 または 1 aH
Cs, Cp		±(1 a ~ 999.999 G) F および 0 F
		分解能 6 桁 または 1 aF
Rs, Rp		± (1 a ~ 999.999 G) Ω および 0 Ω
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
θ z, θ Y	±180°	-180.000°~179.999°, 分解能 0.001°
	0~360°	0.000°~359.999°,分解能 0.001°
	$-360 \sim 0^{\circ}$	-360.000° ~ -0.001°, 分解能 0.001°
	UNWRAP	-9999.999°~+9999.999°,分解能 0.001°
D, Dε, Dμ	l	±(0.00001~99999.9) および 0 (無名数)
		分解能 6 桁または 0.00001
Qc, QL		±(0.00001~99999.9) および 0 (無名数)
		分解能 6 桁または 0.00001
V		0 ~ 9.99999 Vrms
		分解能 6 桁 または 1 aVrms
1		0 ~ 99.9999 mArms
		分解能 6 桁 または 1 aArms
£S, £S', £S"		± (1 a ~ 999.999 G) および 0 (無名数)
μs, μs', μs"		分解能 6 桁 または 1 a
FREQUE	NCY	10 μHz ~ 36.000 000 000 00 MHz
(共振点追尾測定時)		分解能 10 μHz
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

●外部拡張測定モード (IMPD-EXT)

- / I DI JIAJD		
Z		0 Ω ~ 999.999 GΩ
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
R, X		± (1 a ~ 999.999 G)Ω および 0 Ω
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
Υ		0 S ~ 999.999 GS
		分解能 6 桁 または 1 aS
G, B		±(1 a ~ 999.999 G) S および 0 S
		分解能 6 桁 または 1 aS
Ls, Lp		±(1 a ~ 999.999 G) H および 0 H
		分解能 6 桁 または 1 aH
Cs, Cp		±(1 a ~ 999.999 G) F および 0 F
		分解能 6 桁 または 1 aF
Rs, Rp		± (1 a ~ 999.999 G) Ω および 0 Ω
		分解能 6 桁 または 1 aΩ
θ z, θ Y	±180°	-180.000°~179.999°, 分解能 0.001°
	0 ~ 360°	0.000°~359.999°, 分解能 0.001°
	$-360 \sim 0^{\circ}$	-360.000° ~ -0.001°, 分解能 0.001°
	UNWRAP	-9999.999°~+9999.999°,分解能 0.001°
D, Dε, Dμ		± (0.00001 ~ 99999.9) および 0 (無名数)
		分解能 6 桁または 0.00001
Qc, QL		± (0.00001 ~ 99999.9) および 0 (無名数)
		分解能 6 桁または 0.00001
V1, V2		0 ~ 999.999 GVrms
		分解能 6 桁 または 1 aVrms
		PORT1 測定電圧, PORT2 測定電圧を各々の
		入力重み付け設定値で補正した電圧
£S, £S', £S"		± (1 a ~ 999.999 G) および 0 (無名数)
μs, μs', μs	"	分解能 6 桁 または 1 a
FREQUE		10 μHz ~ 36.000 000 000 00 MHz
(共振点追尾測定時)		分解能 10 μHz

●ゲイン・フェーズ測定モード (G-PH)

Gain	
dBR(ゲイン dB)	-999.999 dB ~ +999.999 dB
	分解能 0.001 dB
R(ゲイン絶対値)	0~999.999 G (無名数)
	分解能 6 桁 または 1 a
a(ゲイン実部)	± (1 a ~ 999.999 G) および 0 (無名数)
	分解能 6 桁または 1 a
b(ゲイン虚部)	± (1 a ~ 999.999 G) および 0 (無名数)
	分解能 6 桁または 1 a
θ	
±180°	-180.000°~+179.999°,分解能 0.001°
0 ~ 360°	0.000°~+359.999°, 分解能 0.001°
−360 ~ 0°	-360.000° ~ -0.001°, 分解能 0.001°
UNWRAP	-9999.999°~+9999.999°,分解能 0.001°
GD(群遅延)	± (1 a ~ 999.999 G) s および 0 s,
	分解能 6 桁または 1 as
V1, V2	0 ~ 999.999 GVrms,
	分解能 6 桁 または 1 aVrms
	PORT1 測定電圧, PORT2 測定電圧を各々の
	入力重み付け設定値で補正した電圧

	PORT1 測定電圧, PORT2 測定電圧を各々の
	入力重み付け設定値で補正した電圧
測定端子	
標準測定モード(IMDD ST)
伝学例をモード(Hour/OSC	IIVIPD-31)
コネクタ	DNC 型コシカケ (正面パシリ)
	BNC 型コネクタ(正面パネル)
周波数	10 µHz ~ 36 MHz (HV DC バイアス オフ) 1 kHz ~ 36 MHz (HV DC バイアス オン)
测点信息上点:	設定分解能:10 μHz、確度:±10 ppm (内部基準クロック使用時
測定信号レベル 電圧	0 ~ 3.00 Vrms
电压	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	(例と1690 (VOR)
	「標準 DG / ドイア入設定 [V] = 3.0 (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	I .
	HV DC バイアス設定 [V] ≦ 42.0 ホウム叙述・2 た または 10 m/sma のいずれかまといる
	設定分解能:3 桁 または 10 μVrms のいずれか大きいフ
電流	確度: ±0.3 dB 以内(1 kHz, 70 mVrms ~ 3.0 Vrms, 無負荷 0 ~ 60 mArms
电/ル	0~ 60 marms (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+
	(例と信号D: VV設定 [AIIIIS]
	「標準 DC ハイア人設定 [A]^50 ≥ 5.0 設定分解能:3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方
	確度:公称値
周波数特性	#IQ · 公孙恒 ±0.3 dB 以内(100 kHz 以下)
<i>向放</i> 致付注	±0.5 dB 以内 (1 MHz 以下)
	±1.0 dB 以内 (15 MHz 以下)
	±3.0 dB以内 (30 MHz以下)
	±4.0 dB 以内 (36 MHz 以下)
	1 kHz 基準, 70 mVrms ~ 3 Vrms,
	標準 DC バイアス使用 (設定 0V), 50 Ω負荷
ひずみ率	0.2 % 以下
0 , , , +	(100 kHz 以下, BW500 kHz, 3 Vrms 出力時, 無負荷
ALC	{CV (定電圧) あるいは CC (定電流) } / OFF
出力リミット	電圧:10 µVrms ~ 3.00 Vrms
	設定分解能:3 桁 または 10 μVrms のいずれか大きいブ
	電流:100 nArms ~ 60 mArms
	設定分解能:3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方
 標準 DC バイアス	(正面 Hcur/OSC, 背面 DC BIAS OUT のいずれかを選択)
電圧	-5.00 V ~ +5.00 V
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0
	設定分解能: 10 mV
	確度:±(標準DCバイアス設定[V]の1% +
	測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時
電流	-100 mA ~ +100 mA
	(測定信号レベル設定 [Arms]×71)+
	標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≦ 5.0
	設定分解能: 100 nA 確度: 公称値
HV DC バイアス	-40.0 V ~ +40.0 V (無負荷時)
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	HV DC バイアス設定 [V] ≦ 42.0
	設定分解能: 10 mV
	確度:±(HV DC バイアス設定[V]の1% +
	測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時
	出力インピーダンス: 1 kΩ(公称値)
出力インピーダンス	50 Ω(公称值)

HPOT/PORT1, LCUR/PORT2

入力端子	BNC 型コネクタ(正面パネル)
測定レンジ	10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 ΜΩ, ΑUΤΟ

●高周波測定モード (IMPD-2T) PORT3

コネクタ	NI III - A A A A TITURA III N
ロンナルト	N型コネクタ(正面パネル)
周波数	10 μHz ~ 36 MHz (HV DC バイアス オフ)
	1 kHz ~ 36 MHz (HV DC バイアス オン)
	設定分解能: 10 μHz、確度: ±10 ppm (内部基準クロック使用時
則定信号レベル	
電圧	0 ~ 3.00 Vrms
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	HV DC バイアス設定 [V] ≦ 42.0
	設定分解能: 3 桁 または 10 μVrms のいずれか大きいプ
	確度: ±0.3 dB以内(1 kHz, 70 mVrms~3.0 Vrms, 無負荷
電流	0 ~ 60 mArms
	(測定信号レベル設定 [Arms]×71)+
	標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≦ 5.0
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方
	確度:公称値
周波数特性	±0.3 dB 以内 (100 kHz 以下)
	±0.5 dB 以内 (1 MHz 以下)
	±1.0 dB 以内 (15 MHz 以下)
	±3.0 dB 以内 (30 MHz 以下)
	±4.0 dB 以内 (36 MHz 以下)
	1 kHz 基準, 70 mVrms ~ 3 Vrms,
	標準 DC バイアス使用 (設定 OV), 50 Ω負荷
ひずみ率	0.2 %以下
	(100 kHz 以下, BW500 kHz, 3 Vrms 出力時, 無負荷
ALC	{CV (定電圧) あるいは CC (定電流) } / OFF
出力リミット	電圧:10 μVrms ~ 3.00 Vrms
	設定分解能: 3 桁 または 10 μVrms のいずれか大きい方
	1
	電流:100 narms ~ 60 marms
	電流:100 nArms ~ 60 mArms 設定分解能:3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方
準 DC バイアス	
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方
達 DC バイアス 電圧	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC パイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
電圧	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
電圧	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV), 無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+
	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
電圧	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV). 無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+ 標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≦ 5.0 設定分解能: 100 nA
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV). 無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+ 標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≦ 5.0 設定分解能: 100 nA 確度: 公称値
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≤ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+ 標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≤ 5.0 設定分解能: 100 nA 確度: 公称値 -40.0 V ~ +40.0 V (無負荷時)
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≤ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+ 標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≤ 5.0 設定分解能: 100 nA 確度: 公称値 -40.0 V ~ +40.0 V (無負荷時) (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≤ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% + 測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV). 無負荷時 -100 mA ~ +100 mA (測定信号レベル設定 [Arms]×71)+ 標準 DC バイアス設定 [A]×50 ≤ 5.0 設定分解能: 100 nA 確度: 公称値 -40.0 V ~ +40.0 V (無負荷時) (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ HV DC バイアス設定 [V] ≤ 42.0
電圧	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
電流	設定分解能: 3 桁 または 100 nArms のいずれか大きい方 -5.00 V ~ +5.00 V (測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+ 標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 設定分解能: 10 mV 確度: ± (標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +

●外部拡張測定モード (IMPD-EXT)

Trophabane C 1 (IIVII D-EXT)		
Hcur/OSC 特記なき場合, 試料駆動アンプゲイン設定 K=+1.0, ALC オフ		
コネクタ	BNC 型コネクタ(正面パネル)	
周波数	10 μHz ~ 36 MHz	
	設定分解能:10 μHz、確度:±10 ppm (内部基準クロック使用時)	
測定信号レベル		
設定範囲	0 ~ 999 GVrms	
	K により (0 ~ 3.0) × K Vrms に制限	
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+	
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 × K	
	分解能:3桁 または 10 μVrms (K=1 の時) のいずれか	
	大きい方	
	確度: ±0.3 dB 以内(1 kHz, 70 mVrms~3.0 Vrms, 無負荷)	

_		
	周波数特性	±0.3 dB 以内 (100 kHz 以下)
		±0.5 dB 以内 (1 MHz 以下)
		±1.0 dB 以内 (15 MHz 以下)
		±3.0 dB 以内 (30 MHz 以下)
		±4.0 dB 以内 (36 MHz 以下)
		1 kHz基準, 70 mVrms~3 Vrms,
		標準 DC バイアス使用(設定 OV), 50 Ω負荷
	ひずみ率	0.2 % 以下
		(100 kHz 以下, BW500 kHz, 3 Vrms 出力時, 無負荷)
	ALC	PORT1 / PORT2 / OFF
	出力リミット	1 aVrms ~ 999 GVrms
		設定分解能:3桁 または1 aVrms のいずれか大きい方
材	標準 DC バイアス	−999 GV ~ +999 GV
		K により、-5.00×K V ~ +5.00×K V に制限
		(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
		標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 × K
		分解能:3桁 または10 mV (K=1 の時)のいずれか大きい方
		確度:±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +
		測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時
H	出力インピーダンス	50 Ω (公称值)
Ē	(料駆動アンプ	被測定対象に測定信号を供給するアンプや減衰器のゲインを設定
1	デイン設定 K	試料に加わる測定信号レベル、DC バイアスを直接設定可能
		設定範囲:± (1E-12 ~ 1E+12)
		設定分解能:3 桁または 1E-12 のいずれか大きい方

HPOT/PORT1. LCUR/PORT2

HPOT/PORT1, LCUR/PORT2		
入力端子	BNC 型コネクタ(正面パネル)	
入力インピーダンス	1 MΩ±2% 並列に 25 pF±5 pF (H _{POT}) /	
	30 pF±5 pF (Lcur)	
非破壊最大入力電圧	±20 V	
測定レンジ	10 mVrms ~ 5 Vrms (1-2-5 シーケンス)、	
	7 Vrms、AUTO (PORT1、PORT2 個別設定可)	
	・測定レンジと最大測定入力電圧	
	測定レンジ : 最大測定 測定レンジ : 最大測定 測定レンジ : 最大測定 [rms] : 入力電圧 [rms] : 入力 = [rms] : N	Ē
	10mV ±16mV 100mV ±160mV 1V ±1.6V	$\overline{}$
	20mV ±31mV 200mV ±310mV 2V ±3.1V	
	50mV ±78mV 500mV ±780mV 5V ±7.8V	4
	7V, AUTO ±11V	_
入力重み付け	電圧プローブ、カレントプローブ、プリアンプなどの	
	変換比を補正して測定(PORT1、PORT2個別に設定)	可)
	設定範囲:±(1.00000E-15~999.999E+09)	
	設定分解能:6桁 または 1E-15	
オーバ検出	設定範囲:HPOT/PORT1:0~7 Vrms	
	Lcur/PORT2: 0 ~ 7 Vrms	
	設定分解能:3 桁 または 1μVrms のいずれか大きい	方
	処理:ブザー警告音または測定中止(オン/オフ可)	
DC BIAS OUT		

DC BIAS OUT	
入力端子	BNC 型コネクタ(背面パネル)
設定範囲	−999 GV ~ +999 GV
	K により、-5.00×K V ~ +5.00×K V に制限
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 × K
	分解能:3 桁 または 10 mV (K=1 の時) のいずれか大きい方
	確度:±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +30mV)、
	無負荷時
出力インピーダンス	600 Ω(公称值)

●ゲイン・フェーズ測定モード (G-PH)

Hcur/OSC

I ICOH/ COC	
コネクタ	BNC 型コネクタ(正面パネル)
周波数	10 μHz ~ 36 MHz
	設定分解能: 10 μHz、確度: ±10 ppm (内部基準クロック使用時)
測定信号レヘ	(II)
設定範囲	0~999 GVrms (0~3.0)× K Vrms により制限
	分解能: 3 桁 または 10 μVrms (K=1 の時) のいずれか大きい方
	確度: ±0.3 dB 以内(1 kHz, 70 mVrms~3.0 Vrms, 無負荷)
周波数特性	生 ±0.3 dB 以内 (100 kHz 以下)
	±0.5 dB 以内 (1 MHz 以下)
	±1.0 dB 以内 (15 MHz 以下)
	±3.0 dB 以内 (30 MHz 以下)
	±4.0 dB 以内 (36 MHz 以下)
	1 kHz 基準, 70 mVrms~3 Vrms,
	標準 DC バイアス使用 (設定 0V), 50 Ω負荷
	分解能: 3 桁 または 10 μVrms (K=1 の時) のいずれか大きい 確度: ±0.3 dB 以内 (1 kHz, 70 mVrms ~ 3.0 Vrms, 無負性 ±0.3 dB 以内 (100 kHz 以下) ±0.5 dB 以内 (1 MHz 以下) ±1.0 dB 以内 (15 MHz 以下) ±3.0 dB 以内 (30 MHz 以下) ±4.0 dB 以内 (36 MHz 以下) 1 kHz 基準, 70 mVrms ~ 3 Vrms,

ゲイン・フェーズ測定モード (G-PH) 続き

ノーン フェース例に	L 1 (0111) 100C			
ひずみ率	0.2 % 以下			
	(100 kHz 以下, BW500 kHz, 3 Vrms 出力時, 無負荷)			
ALC	PORT1 / PORT2 / OFF			
出力リミット	1 aVrms ~ 999 GVrms			
	設定分解能:3桁 または1 aVrms のいずれか大きい方			
標準 DC デバイス	−999 GV ~ +999 GV			
	試料駆動アンプゲイン設定 K により、-5.00×K V ~			
	+5.00×K V に制限			
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+			
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 × K			
	分解能:3桁または10 mV (K=1 の時)のいずれか大きい方			
	確度:±(標準DCバイアス設定[V]の1% +			
	測定信号レベル設定 [Vrms] の 3%+30mV)、無負荷時			
出力インピーダンス	50 Ω (公称値)			
試料駆動アンプ	被測定対象に測定信号を供給するアンプや減衰器のゲインを設定			
ゲイン設定 K	回路に加わる測定信号レベル、DC バイアスを直接設定可能			
	設定範囲:± (1E−12 ~ 1E+12)			
	設定分解能:3 桁または 1E−12 のいずれか大きい方			

PORT1/HPOT, PORT2/LCUR

入力端子	BNC 型コネクタ(正面パネル)						
入力インピーダンス	1 MΩ±2% 並列に 25 pF±5 pF (PORT1) /						
	30 pF±5 pF (PORT2)						
非破壊最大入力電圧	±20 V						
測定レンジ	10 mVrms ~ 5 Vrms (1-2-5 シーケンス)、						
	7 Vrms、AUTO(PORT1、PORT2 個別設定可)						
	・測定レンジと最大測定入力電圧						
	測定レンジ: 最大測定 測定レンジ: 最大測定						
	10mV ±16mV 100mV ±160mV 1V ±1.6V						
	20mV ±31mV 200mV ±310mV 2V ±3.1V						
	50mV ±78mV 500mV ±780mV 5V ±7.8V						
	7V, AUTO ±11V						
入力重み付け	電圧プローブ、カレントプローブ、プリアンプなどの						
	変換比を補正して測定(PORT1、PORT2個別に設定可)						
	設定範囲:± (1.00000E−15 ~ 999.999E+09)						
	設定分解能:6桁 または 1E-15						
オーバ検出	設定範囲:HPOT/PORT1:0~7 Vrms						
	Lcur/PORT2: 0 ~ 7 Vrms						
	設定分解能:3 桁 または 1μVrms のいずれか大きい方						
	処理:ブザー警告音または測定中止(オン/オフ可)						
ダイナミックレンジ	110 dB typ. (10 Hz ~ 1 MHz)						
	60 dB typ. (1 MHz ~ 10 MHz)						
	50 dB typ. (10 MHz ~ 36 MHz)						
	(大きい方のポート入力が 3Vrms、測定時間設定 40s 以上)						

DC BIAS OUT

入力端子	BNC 型コネクタ(背面パネル)					
設定範囲	−999 GV ~ +999 GV					
	K により、-5.00 × K V ~ +5.00 × K V に制限					
	(測定信号レベル設定 [Vrms]×1.42)+					
	標準 DC バイアス設定 [V] ≦ 5.0 × K					
	分解能:3桁 または10 mV (K=1 の時)のいずれか大きい方					
	確度: ±(標準 DC バイアス設定 [V] の 1% +30mV)、					
	無負荷時					
出力インピーダンス	600 Ω(公称值)					

▼ 測定信品制御

•	測走信亏利(Eli			
	測定同期駆動	SYNC (AC+DC): 測定信号と DC バイアスを測定開始で			
		オン、測定終了でオフ			
信		SYNC (AC): 測定信号を測定開始でオン、終了でオフ			
号出		ASYNC: 測定開始, 測定終了で変化なし			
信号出力制御	オンオフモード	QUICK:測定信号レベル, DC バイアスを即変更			
制御		SLOW: 10 秒かけて変更			
ITH		0° SYNC: 測定信号の位相 0°のタイミングでオフ			
	周波数変更モード	ASYNC: 即変更、0° SYNC: 位相 0°のタイミングで変更			
	項目	周波数,測定信号レベル,DCバイアス,時間(ゼロスパン)			
	種 類	リニア、ログ(周波数、測定信号レベル)			
	制御	SWEEP UP: 下限 → 上限方向にスイープ			
ス		SWEEP DOWN: 上限 → 下限方向にスイープ			
1		SPOT:固定周波数・測定信号レベル・バイアスで測定			
プ REPEAT: SWEEP または SPOT をオンで繰り返す					
	密度	3 ~ 2,000 steps/sweep			
	時間	周波数:0.5 ms/point~, 測定信号レベル:2 ms/point~			
		DC バイアス: 3 ms/point~, ゼロスパン: 0.5 ms/point~			

▼ 測定確度

●標準測定モード (IMPD-3T) ■

周囲温度 0~+40℃、ウォームアップ 30分以上経過後オープン補正とショート補正を実施 基本確度: ±0.08 %

E-7-1620.00 /0						
測定レンジ Zr	測定範囲	推奨範囲				
1ΜΩ	900kΩ≦	$1M\Omega \sim 11M\Omega$				
100kΩ	90kΩ≦	100kΩ~1.1MΩ				
10kΩ 9kΩ≦		10kΩ~ 110kΩ				
1kΩ	900Ω≦	1kΩ~ 11kΩ				
100Ω	制限なし	9Ω~ 1.1kΩ				
10Ω	≦10Ω	1Ω~ 10Ω				

測定範囲: 測定・表示できるおよその範囲(参考値) 推奨範囲:測定確度が良好となる使用範囲

インピーダンス測定確度

|Z|の確度: ±Az[%]

 $Az = \{(A+B\times U+Kz+Ky)\times Kv+KB\}\times KT$

インピーダンスの位相角θの確度: ±Pz [°] 1 kΩレンジ, 10 kHz < f < 30 kHz のとき

 $Pz = 0.573 \times \{(1.5 \times A + 1.5 \times B \times U + Kz + Ky) \times Kv + KB\} \times KT$

100 Ωレンジ, 10 kHz < f < 30 kHz のとき

 $P_Z = 0.573 \times \{(2 \times A + 2 \times B \times U + K_Z + K_Y) \times K_V + K_B\} \times K_T$

上記以外のとき Pz = 0.573×Az

備老:

- · Az が 10 % を超えるときの測定確度は参考値
- ・その周波数で用いることができる最も高い測定レンジと最も低いレンジを除き、 各測定レンジの推奨範囲の下限の 1/2 より小さい、または上限の 2 倍より大きい 測定値に対する測定確度は参考値

Az, PZ の式中の各パラメタの値を以下に示します。

各パラメタを求めるときに使用する記号の意味を以下に示します。

Zr: 測定レンジ [Ω] Zx: インピーダンスの大きさ | Z | の測定値 [Ω]

U: 比係数

Zr	U		
1kΩ以上	$ Z_{x} / Z_{r} - 1 $		
100Ω以下	$ Z_r / Z_x - 1 $		

A (上段): 基本係数 [%] B(下段): 比例係数 [%]

測定時間設定は、(200 ms または (20÷ 測定周波数 [Hz]) s) の大きい方 以上

測定レンジ	測定周波数 [Hz]							
Zr	2m< f ≦1k	1k< f <30k 30k≦ f ≦50k		50k< f ≦100k				
1ΜΩ	1.50	0.80	_	_				
1 10152	2.00	0.60	_	_				
100kΩ	0.30	0.25	0.70	0.40				
100K12	0.20	0.10	0.70	0.40				
10kΩ	0.15	0.14	0.15	0.20				
10K12	0.03	0.02	0.06	0.03				
1kΩ	0.10	0.09	0.09	0.14				
17/52	0.01	0.01	0.01	0.02				
100Ω	0.13	0.06	0.05	0.06				
10012	0.03	0.04	0.05	0.10				
10Ω	0.30	0.30	0.40	0.40				
1012	0.15	0.20	0.15	0.15				

測定レンジ	測定周波数 [Hz]						
Zr	100k< f ≦1M	1M< f ≦2M	2M< f ≦5M	5M< f ≦10M			
1ΜΩ	_	_	_				
110152	_	_	_				
100kΩ	_	_	_	-			
1001(12	_	_	_	_			
10kΩ	0.20	0.80	_	-			
10002	0.03	0.30	_				
1kΩ	0.15	0.20	0.35	_			
1 1 1 1 1 1	0.01	0.07	0.35	_			
100Ω	0.15	0.15	0.20	0.30			
10012	0.03	0.05	0.20	0.40			
10Ω	0.40	0.50	1.50	_			
1012	1.20	2.00	5.00	_			

「一」の部分の測定確度は保証されません。

Kっ・確四インピーダンフ 区数 [%]

八乙・八田・フレーメンハ (木奴 [70]					
周波数範囲	Kz [%]				
f ≦ 1MHz	2 / Z _X [Ω]				
1MHz <f≦10mhz< th=""><th>$f[kHz]\times2\times10^{-3}/Z\times[\Omega]$</th></f≦10mhz<>	$f[kHz]\times2\times10^{-3}/Z\times[\Omega]$				

Ky:残留アドミタンス係数 [%]

周波数範囲	K _Y [%]
f < 30kHz	Zx [Ω] / (1×10 ⁸)
30kHz≦f≦10MHz	f [kHz]× Z_X [Ω]/(3×10^9)

Kv:信号レベル係数

- ・測定信号レベル設定が 100 mVrms 未満のときは、測定確度は保証されません。
- ・信号レベルを電流で設定したときは、測定信号レベル設定 [Arms]×71 で求めた値を信号レベル [Vrms] として Kv を参照してください。
- 例:測定信号レベル設定が 2.1 mArms のときは,

信号レベル 2.1×10⁻³×71=149 m[Vrms] での Kv を参照します。

測定周波数 ≦1kHz

測定レンジ Zr	信号レベル [Vrms]						
	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	V = 1.00	1.00 < V	
Z r	≦ 300m	≦ 500m	≦ 800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00	
1ΜΩ	5.0	2.5	2.0	1.0	1.0	1.0	
100kΩ	4.0	1.8	2.0	1.0	1.0	2.0	
10kΩ	3.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.5	
1kΩ	2.5	1.2	1.2	1.0	1.0	3.5	
100Ω	1.8	1.1	1.1	1.0	1.0	4.0	
10Ω	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.8	

1kHz<測定周波数 ≦30kHz

THE CONTE							
2016-1 N.25	信号レベル [Vrms]						
測定レンジ	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	V - 1 00	1.00 < V	
Zr	≦ 300m	≦ 500m	≦800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00	
1ΜΩ	5.0	1.8	1.5	1.1	1.0	1.2	
100kΩ	3.5	1.5	1.5	1.1	1.0	2.0	
10kΩ	2.5	1.2	1.2	1.1	1.0	3.0	
1kΩ	2.0	1.2	1.1	1.1	1.0	4.5	
100Ω	2.5	1.2	1.5	1.1	1.0	6.5	
10Ω	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	2.0	

30kHz<測定周波数 ≦100kHz

	CONTIE VIGALISMON = TOOKIE						
201ch 5 .53		信号レベル [Vrms]					
測定レンジ Z _r	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	V - 1 00	1.00 < V	
Zr	≦ 300m	≦ 500m	≦800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00	
100kΩ	8.0	2.5	1.8	1.1	1.0	2.0	
10kΩ	8.0	2.5	1.8	1.1	1.0	3.0	
1kΩ	6.5	2.0	1.5	1.1	1.0	5.0	
100Ω	6.0	2.0	2.0	1.1	1.0	7.0	
10Ω	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.8	

100kHz<測定周波数 ≦1MHz

別中 トご	信号レベル [Vrms]						
測定レンジ Zr	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	., ., .,	1.00 < V	
Z r	≦ 300m	≦ 500m	≦800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00	
10 kΩ	5.0	1.8	1.5	1.0	1.0	3.0	
1 kΩ	4.5	1.5	1.5	1.1	1.0	4.0	
100Ω	4.0	1.2	1.5	1.0	1.0	4.0	
10Ω	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8	

1MHz<測定周波数 ≦2MHz

TWITE VALUE XXX = EWITE							
2016-1 N.25	信号レベル [Vrms]						
測定レンジ Zr	$100\text{m} \leqq \text{V}$	300m < V	500m < V	800m < V	V = 4.00	1.00 < V	
Zr	≦ 300m	≦ 500m	≦800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00	
10kΩ	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	
1kΩ	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	
100Ω	2.0	1.0	1.2	1.0	1.0	4.0	
10Ω	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	

2MHz< 測定周波数 ≦10MHz

2016-1 N.23	信号レベル [Vrms]					
測定レンジ Z _r	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	V - 1 00	1.00 < V
Z r	≦ 300m	≦ 500m	≦800m	< 1.00	V = 1.00	≦ 3.00
1kΩ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
100Ω	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10Ω	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

KB: DC バイアス係数 [%]

- ・標準 DC バイアス設定が 0.00 V のときは、 K_B=0 % です。
- ・標準 DC バイアスを正面パネル Hcur/OSC から出力しているときの KB [%] は、 以下の表のとおり。電圧設定と電流設定共通。

測定レンジ	測定周波数 [Hz]			
Zr	f ≦1k	1k< f ≦30k	30k < f ≦10M	
1ΜΩ	5.0	2.0	_	
100kΩ	1.0	0.2	2.0	
10kΩ	0.2	0.1	0.2	
1kΩ	0.1	0.1	0.1	
100Ω	0.3	0.3	0.3	
10Ω	0.5	0.5	0.5	
10Ω	0.5	0.5	0.5	

・HV DC バイアスが有効なときの KB[%] は以下の表のとおり

測定レンジ	測定周波数 [Hz]			
Zr	1k≦ f <30k	30k< f ≦10M		
1ΜΩ	2.0	-		
100kΩ	0.5	2.0		
10kΩ	0.2	0.2		
1kΩ	0.2	0.2		
100Ω	0.5	0.5		
10Ω	0.5	0.5		

K-· 温度优友区数

周囲温度 T[℃]	Kτ
0 ~ +18	1+k×(18-T)
+18 ~ +28	1
+28 ~ +40	1+k×(T-28)

k:温度係数

1-1-1-1-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
測定レンジ		信号レベル [Vrms]					
Zr	f < 30k	30k ≦ f ≦ 1M	1M < f ≦ 5M	5M < f ≦ 10M			
1ΜΩ	0.04	_	_	_			
100kΩ	0.05	0.04	_	_			
10kΩ	0.05	0.04	0.04	_			
1kΩ	0.06	0.04	0.06	_			
100Ω	0.08	0.05	0.04	0.08			
10Ω	0.03	0.02	0.02	_			

●高周波測定モード (IMPD-2T) =

周囲温度 23±5 ℃, ウォームアップ 30 分以上経過後オープン補正とショート補正を実施

基本確度: ±0.32 %

測定レンジ Zr	測定範囲	推奨範囲	測定範囲: 測定・表示できるおよその範囲
1kΩ	制限なし	90Ω ~ 10kΩ	(参考値)
100Ω	≦ 110Ω	9Ω ~ 100Ω	· 推奨範囲:
10Ω	≦ 11Ω	0.9Ω ~ 10Ω	測定確度が良好となる使用範囲
1Ω	≦ 1.1Ω	$0.09\Omega \sim 1\Omega$	

インピーダンス測定確度

|Z| の確度: $\pm Az$ [%] $Az = \{ (A+B\times U+Kz+Ky)\times Kv+KB \}\times KT$ インピーダンスの位相角 θ の確度: $\pm Pz$ [°] $Pz = 0.573 \times Az$

備考: Az が 10 % を超えるときの測定確度は参考値

Az, Pz の式中の各パラメタの値を以下に示します。 各パラメタを求めるときに使用する記号の意味を以下に示します。

Z_r: 測定レンジ [Ω] Zx: インピーダンスの大きさ | Z | の測定値 [Ω]

U:比係数

Zr	U
1kΩ	Z_X / Z_r (ただし, $Z_X / Z_r < 0.1$ のときは 0.1 にする)
1kΩ以外	Z_r / Z_X (ただし, $Z_r / Z_X < 1$ のときは 1 にする)

A (上段): 基本係数 [%] B (下段): 比例係数 [%]

測定時間設定は、(200 ms または (20÷ 測定周波数 [Hz]) s) の大きい方 以上

测点1.2.25	測定周波数 [Hz]						
測定レンジ	2m < f	1k < f	30k ≦ f	100k < f	1M < f	10M < f	
Zr	≦ 1k	< 30k	≦ 100k	≦ 1M	≦ 10M	≦ 36M	
1kΩ	0.20	0.30	0.30	0.30	1.00	_	
17.52	0.15	0.35	0.15	0.60	2.00	_	
100Ω	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	3.00	
10012	0.03	0.02	0.02	0.02	0.15	0.30	
10Ω	0.20	0.20	0.20	0.20	1.50	_	
1032	0.40	0.30	0.20	0.30	1.00	_	
1Ω	0.40	0.20	0.20	0.40	_	_	
1 12	3.00	3.00	2.00	2.50	_	_	

「一」の部分の測定確度は保証されません。

Kz:残留インピーダンス係数 [%]

周波数範囲	K _Z [%]
f ≦ 100kHz	0.02 / Z _X [Ω]
100kHz <f≦36mhz< th=""><th>f [kHz]×2×10⁻⁴/$Z_X[\Omega]$</th></f≦36mhz<>	f [kHz]×2×10 ⁻⁴ / $Z_X[\Omega]$

Ky:残留アドミタンス係数 [%]

周波数範囲	K _Y [%]
f < 30kHz	Z _X / (1×10 ⁶)
30kHz≦f≦1MHz	f [kHz]× Z_X [Ω]/(3×10 ⁶)
1MHz <f≦36mhz< th=""><th>f [kHz]×$Z_X[\Omega]/(2\times10^6)$</th></f≦36mhz<>	f [kHz]× $Z_X[\Omega]/(2\times10^6)$

Kv:信号レベル係数

- ·信号レベルが 100 mV 未満のときは、測定確度は保証されません。
- ・信号レベルを電流で設定したときは、測定信号レベル設定 [Arms] × 50 で求めた値を信号レベル [Vrms] として Kv を参照してください。

測定周波数 < 30kHz

測定レンジ	信号レベル [Vrms]		
Z_r	100m ≦ V ≦ 300m	300m < V ≦ 1.00	$1.00 < V \le 3.00$
1kΩ	1.2	1.0	3.0
100Ω	1.3	1.0	2.2
10Ω	1.0	1.0	1.5
1Ω	1.0	1.0	1.2

30kHz ≦ 測定周波数 ≦ 1MHz

測定レンジ	信号レベル [Vrms]					
測正レノン Z _r	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	1.00 < V	
Z _r	≦ 300m	≦ 500m	≦ 800m	≦ 1.00	≦ 3.00	
1kΩ	1.5	1.0	1.1	1.0	2.5	
100Ω	1.6	1.0	1.1	1.0	2.2	
10Ω	1.5	1.0	1.0	1.0	2.0	
1Ω	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	

1MHz < 測定周波数

ž	2010年11252	信号レベル [Vrms]				
	測定レンジ	100m ≦ V	300m < V	500m < V	800m < V	1.00 < V
	Zr	≦ 300m	≦ 500m	≦ 800m	≦ 1.00	≦ 3.00
	1kΩ	1.5	1.0	1.1	1.0	1.1
	100Ω	1.6	1.0	1.1	1.0	1.2
	10Ω	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0

KB: DC バイアス係数 [%]

- ・ HV DC バイアスが有効なときは、KB=0.1 % です。
- ・標準 DC バイアスを正面バネル PORT3 から出力しているときの K_B [%] は 以下の表のとおりです。電圧設定、電流設定 共通です。

田油粉茶田	標準DC	バイアス
周波数範囲	OV	≠ 0V
f≦1kHz	0.0	1.00
1kHz < f	0.0	0.05

KT:温度依存係数

	周囲温度 T[℃]	K _T		
	同曲温及 [[0]	f ≦ 10MHz	10MHz < f	
	0 ~ +18	1+0.03×(18-T)	1+0.04×(18-T)	
	+18 ~ +28	1	1	
	+28 ~ +40	1+0.03×(T-28)	1+0.04×(T-28)	

●外部拡張測定モード (IMPD-EXT)/

ゲイン・フェーズ測定モード (G-PH)

周囲温度 $0 \sim +40$ $^{\circ}$ 、 ウォームアップ 30 分以上経過後にセルフキャリブレーションを実施して 12 時間以内、セルフキャリブレーション実施時からの周囲温度変化が ± 5 $^{\circ}$ 以内、試料駆動アンプゲイン設定 K=+1.0,入力重み付け係数は PORT1, PORT2 とも 1.0 のとき

測定確度: 相対確度 + 校正確度

相対確度: ±(基本確度 + ダイナミック確度 + レンジ間確度)

校正確度:本器の外部に接続されるシャント抵抗、プローブ、校正用標準器などの確度

上段: インピーダンス Z (測定モード IMPD-EXT)

中段: ゲイン (測定モード G-PH)

下段:位相

其本な田

本				
and	測定周波数 [Hz]			
測定 レンジ		1M	10M	
[rms]	f ≦1M	< f ≦	< f ≦	
[TIIIS]		10M	36M	
7V	0.12%			
:	0.01dB	0.35%	1.20%	
100mV	0.06°	0.03dB	0.10dB	
50mV	0.24%	0.18°	0.60°	
:	0.02dB			
10mV	0.12°			

条件:

- ・測定時間設定 100ms または (10÷ 測定周波数 [Hz]) s の 大きい方以上
- 10 mVrms ~ 7 Vrms レンジ両ポート同一測定レンジ
- ・レンジフルスケール信号(最大 3Vrms)入力時の Z・ゲイン・

位相の誤差

ダイナミック確度

			XII ·	
:mich	測定周波数 [Hz]		Hz]	・測定時間設定 100ms または
測定 レンジ		1M	10M	(10÷ 測定周波数 [Hz])sの
[rms]	f ≦1M	< f ≦	< f ≦	大きい方以上
[IIIIS]		10M	36M	・10 mVrms ~ 7 Vrms レンジ
7V	0.24%	0.35%	1.20%	・両ポート同一測定レンジ
:	0.02dB	0.03dB	0.10dB	・両ポートへの信号レベルの関係が
100mV	0.12°	0.18°	0.60°	1:1 あるいは 1:0.3 のとき、
50mV		1.20%		入力信号レベル (最大 3Vrms) が
:		0.10dB		大きい方のポートのレンジフル
10mV		0.60°		スケールからレンジ ×0.3 まで変化
				したときの Z・ゲイン・位相の変化分

レンジ間確度

D D INJAETS		WILL FOR SHALL FOR THE	
測定レンジ		測定周波数 [Hz]	
[rms]	f ≦1M	1M< f ≦10M	10M< f ≤ 36M
7V			
5V			1.40%
2V			0.12dB 0.72°
1V	0.24%		0.12
500mV	0.02dB	0.35%	
200mV	0.12°	0.03dB	
100mV		0.18°	1.20%
50mV			0.10dB 0.60°
20mV	0.050/		0.00
10mV	0.35% 0.03dB 0.18°		

条件

条件: ・測定時間設定 100 ms または (10÷ 測定周波数 [Hz]) s の大きい方以上

・ 10 mVrms ~ 7 Vrms レンジ

両ポートの測定レンジが 1 つ異なり、入力信号レベルは両ポート同じ (小さい方の 測定レンジのフルスケールレベル 最大 3 Vrms) ときの Z・ゲイン・位相の誤差

■ Z, θ以外の測定パラメタの測定確度

測定モード: IMPD-EXT, IMP-3T, IMPD-2T

インピーダンスの測定確度から以下のように求めます。 Qx は Q の測定値、Dx は D の測定値, θ x は θ の測定値

確度の計算に用いる θ_X は、 $(90^\circ-tan^{-1}\mid 1/Q_X\mid)$ または $(90^\circ-tan^{-1}\mid D_X\mid)$ で 求めても構いません。

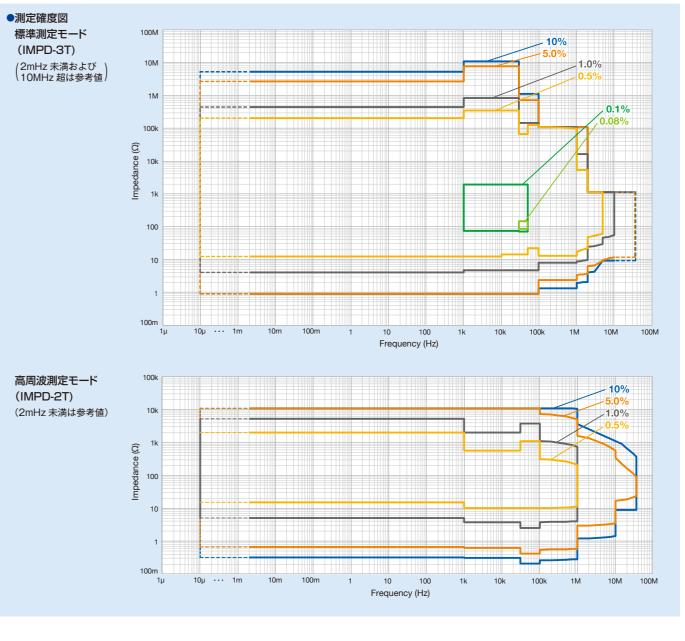
パラメタ	測定確度 (参考値)
Υ , εs, μs	±Az [%]
Lp, Ls, X, ϵ s', μ s'	$\pm Az \ [\%] \ (Qx \ge 10), \ \pm Az / \sin \theta x \ [\%] \ (Qx < 10)$
CP, Cs, B	$\pm Az$ [%] (Dx ≤ 0.1), $\pm Az / \sin \theta x$ [%] (Dx > 0.1)
Rp, Rs, G, ϵ s", μ s"	$\pm Az \ [\%] \ (Qx \le 0.1), \ \pm Az \ / \cos \theta \times [\%] \ (Qx > 0.1)$
	$\pm Qx^2 \times P_e / (1- Qx \times P_e)$ ($ Qx \ge 10$ あるいは $ Qx \times P_e \le 0.1$)
Q	ここで位相角の誤差Pe [rad]=Pz [°] / 57.3
	Qの測定確度は値そのもので、%値ではありません。
D	$\pm (P_Z [^{\circ}] / 57.3) (D_X \le 0.1)$
D	Dの測定確度は値そのもので、%値ではありません。

■ Gain, *θ*以外の測定パラメタの測定確度 測定モード: G-PH

位相の測定確度から次のように求めます。ここで、PG は θ の測定確度 [°] です。

パラメタ	測定確度 (参考値)	
GD	$\pm \frac{P_G}{360 \times APT}$ [s]	APTはアパーチャ周波数(⊿f [Hz])で、 アパーチャ設定*×スイーブ測定周波数 間隔です。

*「アパーチャ設定」とは、 群遅延 (GD) 測定のために設定するパラメタです。



▼ 測定処理部

▼ 例是处理的		
測定時間設定	1回の測定に要する時間の設定(スイープ各点毎の測定	
	時間の設定)、設定時間を超えない範囲で測定結果は平均化	
	設定範囲:0 ms ~ 9,990 s	
	設定分解能:3 桁または0.1 ms のいずれか大きい方	
測定遅延機能	スイープパラメタ変更後、測定開始を遅延	
	設定範囲:0~9,990 s	
	設定分解能:3 桁または0.1 ms のいずれか大きい方	
測定開始遅延機能	スイープ開始時のみ、測定開始を遅延	
	設定範囲:0~9,990 s あるいは MANual	
	設定分解能:3 桁または0.1 ms のいずれか大きい方	
自動高密度スイープ	周波数スイープ測定で、測定データが急激に変化する時に	
	自動的にその前後区間の周波数スイープ密度を上げて測定	
	・測定モード IMPD-3T, IMPD-2T, IMPD-EXT	
	Z:1 a ~ 999 GΩ 設定分解能 3 桁または 1 aΩの大きい方	
	Y:1a~999 GS 設定分解能3 桁または1aSの大きい方	
	θ: 0.001 ~ 179.999° 設定分解能 0.001°	
	・測定モード G-PH	
	Gain: リニア 1a ~ 999G 設定分解能 3 桁または 1 a の大きい方	
	ログ 0.001 ~ 999.999 dB 設定分解能 0.001 dB	
	θ: 0.001 ~ 179.999° 設定分解能 0.001°	
シーケンス測定機能	設定条件ファイルの内容に従って測定を行う機能	
	· UP SWEEP	
	設定条件ファイル番号 1 の設定で、次にファイル番号2、と	
	上限設定条件ファイル番号まで連続してアップスイーブ測定	
	DOWN SWEEP	
	最初に上限設定条件ファイル番号の設定で、次に[設定	
	条件ファイル番号 -1] の設定、最後にファイル番号 1まで	
	連続してダウンスイープ測定	
	上限設定条件ファイル番号:1 ~ 32, 設定分解能:1	

共振点追尾機能	測定周波数を、試料の共振周波数に自動的に追尾する
等価回路推定機能	周波数スイープ測定結果から、等価回路の各定数を計算
(G-PHモードを除く)	※等価回路モデルは P.7 参照
圧電定数算出機能	周波数スイープ測定結果から、圧電関連定数を計算
(G-PHモードを除く)	圧電定数算出:圧電定数, 圧電パラメタ, 特徴的周波数など
	シミュレーション:圧電パラメタよりアドミタンス特性を計算・表示
コンパレータ	SPOT 測定結果: 最大 14 分類
	SWEEP 測定結果:上限·下限判定
	判定値設定数:1~20
放電保護	保護耐量: 2 J 以下(電圧 100V 以下)(IMPD-3T, IMPD-2T)
誤差補正機能	<g-phモード除く></g-phモード除く>
	・オープン補正:浮遊アドミタンスを補正
	・ショート補正:残留インピーダンスを補正
	・ロード補正:測定系の電圧・電流変換係数を補正
	ロード標準値:最大 30 点の周波数で校正値を入力可
	・ポート延長:2端子測定時、ケーブルの位相遅れによる誤差を補正
	特性インピーダンス: 1.00 ~ 999 Ω, 設定分解能 3 桁
	電気長: 0.000 ~ 999.999 m,設定分解能 0.001 m
	・電位勾配除去 <impd-extモードのみ>:</impd-extモードのみ>
	信号に重畳している DC レベルが時間と共に直線的に変化
	しているときに、その影響を受けずに分析
	(充放電中の電池のインピーダンス測定時に使用)
	・イコライズ <g-phモードのみ>:</g-phモードのみ>
	測定系の周波数特性をあらかじめ測定し、本測定時に
	測定系の誤差分を取り除き、被測定系のみの特性を得る
	・セルフキャリブレーション <impd-ext, g-phモードのみ="">:</impd-ext,>
	本器内で生じる誤差を自己測定し補正する機能

▼ 表示部

▼ 3571/Db	
表示器	8.4 インチカラー TFT-LCD (SVGA) タッチパネル付き
グラフ	ボード線図、ナイキスト線図、コールコールプロット
グラフ表示スタイル	SINGLE:画面に1つのグラフを表示
	SPLIT : 画面に2つのグラフを上下に表示
グラフ軸設定	X, Y1, Y2 軸 各々リニア/ログ 設定可
グラフトレース	測定データ (MEAS)、参照データ (REF1 ~ 8) の 9 本
オートスケーリング	グラフの表示スケールを自動的に最適に設定(オン/オフ可)
マーカ表示	グラフ上にマーカを表示し、マーカ位置のデータを数値で表示
マーカサーチ機能	Max, Min (最大値, 最小値)、Peak, Bottom (ピーク(極大値),
検索項目	ボトム (極小値))、Next Peak (次のピーク)、Next Bottom
	(次のボトム)、Prev Peak (前のピーク), Prev Bottom (前の
	ボトム)、Value (マーカ値)、△Value (基準マーカと検索マーカ間
	の差)、X Value (スイープパラメタ値)、BW1 (通過域ゲイン,
	遮断周波数表示)、BW2 (センター周波数, 通過帯域幅を表示)、
	BW3 (ノッチ周波数,ノッチ帯域幅を表示)
	※スイーブ測定終了時に自動サーチ可能

▼ メモリ

測定条件	32組 (測定モードごと)
測定データ (MEAS)	スイープ測定したデータ
	内部ストレージに最大 32 データを保存可
参照データ (REF)	測定データ (MEAS) と一緒に表示可能なデータ (最大 8)
	測定データや USB メモリからコピー可、表示オン/オフ可
誤差補正データ	オープン補正、ショート補正、ロード補正、ポート延長
	先端オープン補正、ポート延長先端ショート補正、ポート
	延長先端ロード補正、イコライズデータ 各々32組

▼ 外部記憶

媒体	USB メモリ
コネクタ	正面パネル、USB-A コネクタ
ファイルフォーマット	FAT
保存項目	設定条件、測定データ (MEAS)、参照データ (REF1 ~8)、
	等価回路推定結果、圧電定数算出結果、マーカ情報
ファイル形式	CSV 形式
画面イメージ	USB メモリに LCD 画面ハードコピーを保存可
	MS Windows ビットマップファイル(.BMP)

▼ 外部入出力機能

インタフェース	GPIB: IEEE488.1, IEEE488.2
	USB: USB2.0 HighSpeed, USBTMC
	LAN: 10/100 Base-T
	RS-232: 4800 ~ 230400 bps
外部モニタ	プロジェクタ、外部モニタなどの接続用
	VGA (ミニ D-Sub15 ピン、メス)、800×600 (SVGA)、
	アナログ RGB コンポーネント映像信号
基準クロック入力	周波数: 10 MHz ±100 ppm 以内
	入力波形:正弦波または方形波
	入力電圧: 0.5 Vp-p~5 Vp-p
	入力インピーダンス: 300 Ω(公称値)、AC 結合
基準クロック出力	周波数: 10 MHz ±10 ppm (内部基準クロック使用時)
	出力波形:1 Vp-p / 50 Ω、方形波
	出力インピーダンス:50 Ω(公称値), AC 結合
ハンドラ	すべての入出力端子を光絶縁(耐電圧 ±42 V)
インタフェース	入力信号:トリガ, 設定ファイル番号
(G-PHモード除く)	出力信号: 判定結果 BIN 1 ~ BIN 14
拡張コネクタ	AUX コネクタ

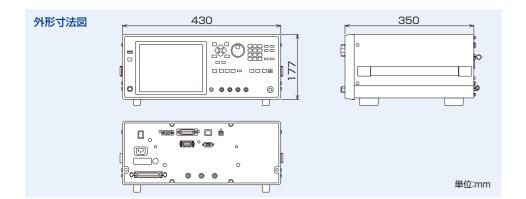
▼ 一般事項

電源入力	AC100 V ~ 230 V ±10%、ただし250 V 以下
	50 Hz / 60 Hz ± 2 Hz、消費電力最大 100VA、
	過電圧カテゴリ Ⅱ
動作温度・湿度	0~+40°C、5~85% RH
範囲	(ただし、絶対湿度 1 ~ 25 g/m³、結露がないこと)
外形寸法 (mm)	430 (W)×177 (H)×350 (D) (突起物を除く)
質 量	約 7.0 kg
RoHS 指令	Directive2011/65/EU
ウォームアップ	30 分以上
校正周期	1年
付属品	取扱説明書(基本編、応用編、外部制御 各1)、
	電源コードセット (3 ピンプラグ付き, 2m) 1、
	キャリブレーションボックス 1、100 Ωレジスタ 1





※保守用として、オプションにて販売しています。



テストフィクスチャ・テストリード

● 汎用部品

さまざまな形状の測定対象を安定して測定。



4端子ワニグチクリップ テストリード 2324

4端子接続

• 測定周波数 ≤100kHz



2325AL(標準クリップ)

ケルビンクリップテストリード 2325AL/2325AM

4端子接続

測定周波数 ≤100kHz



ケルビンクリップテストリード ZM2392

4端子接続

測定周波数 ≤20kHz



3端子ワニグチクリップ テストリード ZM2391

• 2端子接続

測定周波数 ≤20kHz



ワニロクリップテストリード 1505

4端子接続

●測定周波数 ≤3MHz



ケルビンクリップテストリード (Mサイズ) 40100

4端子接続

●測定周波数 ≤3MHz



ケルビンクリップテストリード (Lサイズ) 40180

• 4端子接続

●測定周波数 ≤3MHz

● チップ部品



チップテストフィクスチャ ZM2394H

• 2端子接続

測定周波数 ≤36MHz

対応部品サイズ: 0603(厚さ0.3mm)~14mm角

チップテストフィクスチャ ZM2393

2端子接続

測定周波数 ≤1.2MHz

• 対応部品サイズ:1608~5750



チップテストフィクスチャ 1024

- 2端子接続
- 測定周波数 ≤120MHz
- 最小部品サイズ: 0603



チップテストフィクスチャ 1012(2端子接続)/1014(4端子接続)

- 測定周波数 ≤120MHz
- 最小部品サイズ: 1608



底面電極用チップテストフィクスチャ 1032 (2端子接続) / 10324 (4端子接続)

測定周波数 ≤120MHz

2端子接続または4端子接続で表面実装部品を測定。

- 最小部品サイズ:
- 1608(1032)/3216(10324)
- 底面に電極があるチップ部品用



チップ部品用テストリード

- ZM2366
- 3端子接続 測定周波数 ≤10MHz
- 先端間隔 1~8mm(typ.)
- 測定周波数 ≤1.2MHz
- 免端間隔 1~8mm(typ.)



チップ部品用テストリード 2326A

- 3端子接続



チップ部品用テストリード (Sサイズ) 40120

4端子接続

● 特定用途 -

●測定周波数 ≦3MHz



チップ部品用テストリード(Sサイズ) 40125 チップ部品用テストリード(Lサイズ) 40125A

- 2端子接続
- 測定周波数 ≤120MHz

● リード部品 -----

試料のリードを差し込むだけで測定が可能。



テストフィクスチャ ZM2363

- 4端子接続
- 測定周波数 ≤10MHz



リード部品用テストフィクスチャ 1011

- 2端子接続
- 測定周波数 ≤120MHz



- 1020 • 2端子接続
- 測定周波数 ≤40MHz

薄膜測定治具

- 適合試料形状:薄膜
- C、D測定用、誘電率・比誘電率の測定に (別売)が必要



薄膜や液体の各種素材特性の測定に。

液体用テストフィクスチ 1022

• 2端子接続

測定周波数 ≤40MHz • 専用4端子-2端子変換アダプタ

オプション

型名 PA-001-3233

品名

備考 保守用 保守用 EIA 規格ラック用 JIS 標準ラック用



100Ωレジスタ キャリブレーションボックス PA-001-3234 PA-001-3270 ラックマウントキット (EIA) PA-001-3271 ラックマウントキット (JIS)

関連製品





最大250Aの大電流を重畳可能

周波数特性分析器 FRA51615

- ■測定周波数 10 µ Hz ~ 15MHz
- ●利得確度 ±0.01dB、 位相確度 ±0.06°
- ●最大電圧 600Vrms (600V/CAT II、300V/CAT III)
- ●測定速度 0.5ms/point ●ダイナミックレンジ 140dB
- ■インピーダンス測定
- オープン/ショート/ロード補正、ポート遅延機能

LCRメータ ZMシリーズ

- 測定周波数 1mHz~100kHz (ZM2371/ZM2372)測定周波数 1mHz~5.5MHz (ZM2376)
- ●基本確度 0.08% ■測定時間 最速 2ms
- 測定信号レベル 10mVrms~5Vrms/1 μ Arms~200mArms
- ●定電圧/定電流駆動、DCR測定、コンパレータ、標準偏差、 コンタクトチェック機能、データ取り込み用アプリケーションソフトウエア

DCバイアス重畳 インダクタンスアナライザ

インダクタンスアナライザ 3260B

- ●測定周波数 20Hz~3MHz
- ■基本確度 0.1%
- ■インピーダンス測定レンジ 最大2GΩ

DC バイアス電流源 3265BQ

- ●周波数 20Hz~3MHz
- ●最大電流出力25A
- ■専用テストフィクスチャ リード部品用250A/チップ部品用125A
- ※120MHzまでの高周波における電流重畳に対応する機種も御用意。

●外部拡張測定モード (IMPD-EXT) において、ZA57630 と組み合わせて測定可能なパワーアンプとプリアンプ。

バイポーラ電源

高速バイポーラ電源 HSAシリーズ

- ●最大300Vp-p
- ●DC~最高1MHz
- スルーレート 最高475V/μs
- ●5機種



HSA42011 (1MHz/3Ap-p)

バイポーラ電源 BPシリーズ

- ●±60V、120Vp-p
- ●±10A~±100A(10機種)
- ●DC~150kHz
- ●定電圧/定電流



BP4610(10A)

プリアンプ

プログラマブル電流増幅器 CA5351

- ●高利得 10³ V/A~10¹⁰ V/A
- ●広帯域 DC~500kHz(10⁶ V/A)
- ●高速応答 0.7 µs(10⁶ V/A)



低雑音増幅器 SAシリーズ

- ●電圧入力モデル: 最高500MHz、11機種
- ●電流入力モデル:
- 高利得・広帯域、6機種

取扱代理店 -



世界最高クラスの低ノイズ

計測HOTLINE

50 0120-545838

- ※このカタログの記載内容は、2025年9月16日現在のものです。
- ●お断りなく外観・仕様の一部を変更することがあります。
- ●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。

株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本 社・営業本部 〒223-8508 横浜市港北区綱島東6-3-20 045-545-8111

■東 北 022-722-8163 ■ 北関東 028-305-8198 ■関 東 03-6907-1401

■東 京 045-545-8132 ■横 浜 045-545-8136 ■名古屋 052-777-3571

■大阪 072-623-5341 ■広島 082-503-5311 ■九州 092-411-1801

https://www.nfcorp.co.jp/